

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年 8月10日

出願番号

Application Number:

特願2000-243185

出願人

Applicant(s):

キヤノン株式会社

2001年 8月24日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造

出証番号 出証特2001-3075846

【書類名】 特許願

【整理番号】 4266075

【提出日】 平成12年 8月10日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H04N 5/32

【発明の名称】 放射線撮像装置、それを備えた放射線撮像システム及び
それに備えられたファイバプレート基体

【請求項の数】 8

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会
社内

【氏名】 梶原 賢治

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会
社内

【氏名】 浜本 修

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代表者】 御手洗 富士夫

【代理人】

【識別番号】 100065385

【弁理士】

【氏名又は名称】 山下 穰平

【電話番号】 03-3431-1831

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 010700

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9703871

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 放射線撮像装置、それを備えた放射線撮像システム及びそれに備えられたファイバプレート基体

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 放射線を光に変換する波長変換手段と、変換されることによって得られた前記光を電気信号に変換する光電変換手段と、前記波長変換手段と前記光電変換手段との間に設けられ前記波長変換手段からの光を前記光電変換手段へ導く複数のファイバプレートとを有するファイバプレート基体とを備えた放射線撮像装置であって、

前記ファイバプレート基体は、複数の前記ファイバプレートを相互に前記放射線を遮蔽する遮蔽性を有する接着部を介して貼り合わせることによって作成されている放射線撮像装置。

【請求項 2】 前記接着部は、前記放射線を遮蔽する遮蔽性部材が分散された接着材によって形成され、接着材の硬化反応で前記複数のファイバプレートを相互に接合する請求項 1 に記載の放射線撮像装置。

【請求項 3】 前記接着部は低融点金属であって、融点以上の温度に加熱して複数の前記ファイバプレートを相互に融着する請求項 1 に記載の放射線撮像装置。

【請求項 4】 前記低融点金属を液状のフラックス中に分散させ、該液体を複数の前記ファイバプレート間に充填し融着する請求項 3 に記載の放射線撮像装置。

【請求項 5】 前記ファイバプレートの接続面に設けられる第 1 の金属層と該第 1 の金属層に設けられる第 2 の金属層とを備え、前記第 2 の金属層が前記低融点金属あることを特徴とする請求項 3 又は 4 に記載の放射線撮像装置。

【請求項 6】 前記第 1 の金属層を無電解メッキ法で、第 2 の金属層を電気メッキ法で層形成したことを特徴とする請求項 5 に記載の放射線撮像装置。

【請求項 7】 請求項 1 から 6 のいずれか 1 項に記載の放射線撮像装置と、前記放射線撮像装置からの信号を処理する信号処理手段と、前記信号処理手段からの信号を記録するための記録手段と、

前記信号処理手段からの信号を表示するための表示手段と、
前記放射線を発生させるための放射線源とを具備する放射線撮像システム。

【請求項 8】 請求項 1 から 6 のいずれか 1 項に記載の放射線撮像装置に備えられていることを特徴とするファイバプレート基体。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、放射線を光に変換する波長変換手段と、変換されることによって得られた光を電気信号に変換する光電変換手段と、波長変換手段からの光を光電変換手段へ導くファイバプレート基体とを備えた放射線撮像装置、それを備えた放射線撮像システム及びそれに備えられたファイバプレート基体に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

従来、放射線撮像装置、特に医療を目的とする X 線撮影装置では X 線動画が可能で画像品位が優れ、かつ、薄型で大面積入力範囲を有する X 線撮像装置が求められている。また医療用のみならず、産業用非破壊検査機などにも薄型で安価な大面積の X 線撮像装置が求められている。

【 0 0 0 3 】

このような X 線撮像装置としては、例えば、(1) ファイバプレートのファイバ繊維に傾斜を設け CCD センサの非受光部 (周辺回路) が干渉しあうことを防ぎ大面積化した X 線検出装置 (例えば、米国特許第 5,563,414 号)、(2) ファイバプレートの厚みに段差をつけて CCD センサの非受光部が干渉しないように大面積化した X 線検出装置 (例えば、米国特許第 5,834,782 号) などがある。

【 0 0 0 4 】

上記 (1) の構成の X 線検出装置の概略的断面図を図 1 1 に示す。図 1 7 には、X 線を可視光に変換するシンチレータなどからなる蛍光体 3 と、蛍光体 3 によって変換された可視光を撮像素子 1 側へ導く光ファイバなどのファイバプレート 2 と、ファイバプレート 2 によって変換された可視光を電気信号に変換する撮像素子 1 とを示している。

【 0 0 0 5 】

このX線撮像装置は、ファイバースプレートを2枚を撮像素子1に対して傾斜を設けており、ファイバースプレートの間には、各撮像素子1からの電気信号を処理する処理回路等が設けられている。上記(2)の構成のX線検出装置の概略的斜視図を図18に示す。なお、図18において、図17と同様の部分には、同一の符号を付している。図18に示すように、ファイバースプレートの長さを変えて、たとえば3つの撮像素子1を一組として各組毎に段差を設けることによって、各撮像素子1に処理回路等を備えられるようにしている。

【 0 0 0 6 】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、上記(1)の構成は、まず、斜めにファイバースプレートを切断するため、ファイバースプレートの加工が困難なこと、加えてロット当りの取り個数が少なくなるので価格が高くなるといった問題がある。また、傾斜を設けると、ファイバースプレートの各ファイバーで光の伝送効率が悪くなりセンサーの感度が低下する。

【 0 0 0 7 】

さらに、図示したものは2×2ブロックのファイバースプレートを貼り合わせたもので、現有するファイバースプレートを使用时100×100mm程度の大きさが限界である。しかるにファイバーの傾斜を変えて3×3等にすると、各撮像素子内の画素のうち、中央に配置しているファイバースプレートよりも、周辺に配置しているファイバースプレートの方が光の透過率が劣り、各撮像素子から出力される信号にムラが生じる。

【 0 0 0 8 】

また、上記(2)の構成は、X線撮像装置が大型化するという問題がある。また、各段差部分と撮像素子との位置合わせ精度が厳しいため、製造工数が多くなり、且つ高精度な位置合わせ装置が必要になる。これらを鑑みると上記(2)の構成は現実的ではない。上記従来のX線撮像装置では、X線撮像装置の大型化、低コスト化、製造工程での作業性等の要請に対して必ずしも十分なものではなかった。

【0009】

そこで、本発明は、X線撮像装置の大型化、低コスト化に適し、製造工程での作業性により優れた放射線撮像装置及び放射線撮像システムを提供することを課題とする。

【0010】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために、本発明は、放射線を光に変換する波長変換手段と、変換されることによって得られた前記光を電気信号に変換する光電変換手段と、前記波長変換手段と前記光電変換手段との間に設けられ前記波長変換手段からの光を前記光電変換手段へ導く複数のファイバプレートとを有するファイバプレート基体とを備えた放射線撮像装置であって、前記ファイバプレート基体は、複数の前記ファイバプレートを相互に放射線を遮蔽性する物質を含む接着材を用いて貼り合わせることによって作成されている。

【0011】

また、本発明の放射線撮像システムは、上記放射線撮像装置と、前記放射線撮像装置からの信号を処理する信号処理手段と、前記信号処理手段からの信号を記録するための記録手段と、前記信号処理手段からの信号を表示するための表示手段と、前記放射線を発生させるための放射線源とを具備する。

【0012】

さらに、本発明のファイバプレート基体は、上記の放射線撮像装置に備えられている。

【0013】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。なお、本発明の撮像装置は以下に説明するX線撮像装置に好適に用いることができるが、特にその用途がX線撮像装置に限定されず、 α 、 β 、 γ 線等のX線以外の放射線を検出する放射線撮像装置に用いることができる。

【0014】

(実施形態1)

図 1 は、本発明の X 線撮像装置の断面図である。図 1 には、X 線を可視光等の撮像素子（光電変換手段）で検知可能な波長の光に変換するシンチレータとしての蛍光体（波長変換手段）3 と、蛍光体 3 によって変換された光を撮像素子側へ導く複数の光ファイバからなるファイバプレート 2 と、ファイバプレート 2 を相互に接着する接着部 7 と、ファイバプレート 2 と複数の画素を備えた撮像素子 1 とを接着する弾性に優れた透明接着材 6 と、光を電気信号に変換する撮像素子を備えた撮像素子 1 と、撮像素子 1 からの電気信号を外部に出力するフレキシブル基板 4 と、フレキシブル基板 4 と撮像素子 1 とを電氣的に接続する bumps 5 と、蛍光体 3 を保護するアルミ保護シート 8 と、撮像素子 1 を搭載するベース基板 10 と、ベース基板 10 を保持するためのベース筐体 11 と、ベース筐体 11 に備えられた筐体カバー 9 と、撮像素子 1 とファイバプレート 2 との間に設けられた一定間隔を保持するためのスペーサ 13 と、透明接着材 6 をファイバプレート 2 と撮像素子 1 との間に介在させるための目地うめ接着材 14 とを示している。

【0015】

図 1 に示す X 線撮像装置は、撮像素子 1 とファイバプレート 2 を複数備えたファイバプレート基体とを、透明接着材 6 によって貼り合わせることによって、形成している。

【0016】

図 2 は、撮像素子 1 の概略的な構成を示す平面図である。図 2 には、2 次元配列した複数の撮像素子を含む通常画素 101 と、駆動回路 103 の外側に設けられた複数の周辺画素 104 と、各通常画素 101 及び各周辺画素 104 を順次駆動する駆動回路 103 と、撮像素子 1 の入出力端子 102 とを示している。

【0017】

通常画素 101 は、ほぼ撮像素子 1 の全面に配しており、通常画素 101 のピッチは、後述するように、たとえば $160 \mu\text{m}$ としている。通常画素 101 間には駆動回路 103 を分割して分散配置している。なお、周辺画素 104 は、通常画素 101 に比べて面積が小さいため、画素信号を補正処理することによって、面積の相違がなくなるようにしている。

【0018】

図3(a)は、バンプ5及びフレキシブル配線基板4付近の概略的断面図、図3(b)は、図3(a)の上面図である。図3には、図1、図2に示した部材の他に、バンプ5に接続されるフレキシブル基板4のインナーリード401と、撮像素子1の端部とインナーリード401とのショートの防止及び撮像素子1の端部欠損を防止するポリイミド樹脂層などの有機絶縁層105とを示している。

【0019】

図4は、図3に示したバンプ5とフレキシブル基板4との電氣的接続の様子を示す図である。はじめに、有機絶縁層105としてたとえばポリイミド樹脂層を $25\mu\text{m}$ の厚さとなるように形成する。次に、バンプ5とフレキシブル基板4との電氣的接続を行うために、まず、撮像素子1の入出力端子102に、スタッドバンプ方式やメッキなどによりバンプ5を形成する。

【0020】

そして、バンプ5とインナーリード401とを、たとえば超音波により金属間接合する。ちなみに、インナーリード401は、銅箔などをエッチングすることによって形成し、ニッケル及び金を用いてメッキを施して、 $18\mu\text{m}$ 程度の厚さとし、またフレキシブル配線基板の総厚は、 $50\mu\text{m}$ 程度としている。

【0021】

次に、撮像素子1を保持台17、18によって保持した状態で、治具19を保持台17、18の方向に移動させる。こうして、撮像素子1の端部でインナーリード401を図面下側に向けて 90° 程度曲げる。

【0022】

図5(a)は、撮像素子1のフレキシブル配線基板4付近の拡大図である。図5(b)は、図5(a)の平面図である。図5に示すように、図中、X方向の長さは周辺画素104の幅が通常画素101の幅より小さくなっており($S_1 < S_2$)、各周辺画素104間及び各通常画素101と各周辺画素104との間のピッチは一定となるように配置されている($P_1 = P_2 = P$)。さらに、各通常画素101間のピッチも同ピッチ(P)となるように配置されている。このことから、画素ピッチはすべて等ピッチとなり、画像品位は劣らない。

【 0 0 2 3 】

図 6 は、撮像素子 1 とベース基板 1 0 との接着工程を示す図である。まず、図 4 を用いて説明したように、フレキシブル基板 4 を備えた複数の撮像素子 1 を、X、Y、Z 方向及び θ (回転) 方向に可動するアライメントヘッド及びアライメントカメラを用いて位置合わせしながらステージ上に載置する。このとき、各撮像素子 1 は、ステージに形成されている孔からバキューム装置などで吸引されることによってステージ上に固定される (図 6 (a))。

【 0 0 2 4 】

この状態で、各撮像素子 1 が所要の動作を行うかどうかの検査を行う。この検査では、検査治具を用いて、たとえば静電気などによって各撮像素子 1 が破壊されているかどうかなどを調べる (図 6 (b))。そして、検査の結果、撮像素子 1 に欠陥が発見されれば、その撮像素子の下方のバキューム装置をオフして、アライメントヘッドを用いて交換する (図 6 (c))。

【 0 0 2 5 】

つづいて、撮像素子 1 上に、紫外線硬化型又はシリコン樹脂などの接着材を塗布する (図 6 (d))。そして、ベース基板 1 0 に設けられた長孔にフレキシブル基板 4 を挿入し、それから撮像素子 1 とベース基板 1 0 とを密着させた後に紫外線を照射したり加圧することによって接着する (図 6 (e))。なお、図 6 (e) に示すように、ファイバースプレートの大きさと撮像素子 1 との大きさを同じにして、これらを位置合わせするとよい。また、ここでは、ベース基板 1 0 には、撮像素子 1 との間における熱膨張率などを考量して、ガラス又はパーマアロイ (鉄+ニッケル) 合金を用いている。

【 0 0 2 6 】

そして、撮像素子 1 とベース基板 1 0 とを接着した後、撮像素子 1 及びベース基板 1 0 を取り外す (図 6 (f))。

【 0 0 2 7 】

図 7 は、撮像素子 1 及びベース基板 1 0 とファイバースプレートを貼り合わせる工程の説明図である。なお、図 7 (a) 及び図 7 (c) は、断面図、図 7 (b) 及び図 7 (d) は平面図としている。図 6 を用いて説明したように、ベ-

基板 1 0 と接着した各撮像素子 1 上に、各撮像素子 1 とファイバープレート基体との間隔を保持できるように、スペーサ 1 3 を配置する（図 7（a））。スペーサは球でも円柱形状でも良い。つぎに、シール材及び目地うめ接着材を、撮像素子 1 上に塗布する（図 7（b））。目地うめ接着材は撮像素子 1 間の隙間を埋めるために充填されるものである。シール材は、図 7（b）に示すように一部が開口されており、後述するように、ここから真空注入の方式を用いて透明接着材 6 を充填する。注入する際、真空リークの原因とならぬように目地うめ接着材を撮像素子 1 間の隙間に充填している。

【 0 0 2 8 】

それから、スペーサ 1 3 上に、ファイバープレート基体を貼り合わせる（図 7（c））。さらにファイバープレート 2 を相互に接着する接着部 7 が、各撮像素子 1 間の隙間あるいは各画素間の直上に配置されるように行くとライン欠陥を解消することができ、より好ましい。

【 0 0 2 9 】

加圧、加熱プレスにより撮像素子 1 とファイバープレートの間隔を均一にし、シール材を硬化させる。そして、真空チャンバー内で、ファイバープレート基体と各撮像素子 1 との隙間を真空状態にしたところで、透明接着材 6 を溜めたボートに開口部分をつけ真空状態を大気圧に戻すことで、透明接着材 6 が隙間に充填される。その後、開口部分を封止する（図 7（d））。それから、たとえばシート上の蛍光体 3 をファイバープレート基体上に貼りつけることによって、X線撮像装置が形成される。

【 0 0 3 0 】

なお、蛍光体 3 はファイバープレート基体上に蒸着する手法や粉末状の蛍光体を結合材に混合させて塗布することによって設けることもできるが、この場合、図 7（c）を用いて説明した工程の前に、ファイバープレート基体上に蛍光体 3 を設けておく。

【 0 0 3 1 】

つぎに、図 1 を用いて X 線撮像装置の動作について説明する。蛍光体 3 側に図示しない X 線源を設置し、さらに、X 線源と X 線撮像装置との間に被写体を位置

させた状態で、X線源からX線を照射すると、そのX線は被写体に曝射される。すると、X線は被写体を透過するとき強度差を有するレントゲン情報を含んでX線撮像装置側に送られる。

【 0 0 3 2 】

X線撮像装置側では、蛍光体3において、X線の強度に応じた可視光等の光に変換される。変換されることで得られた光は、ファイバプレート2を通じて撮像素子1側へ伝送される。このとき、ファイバプレート2と撮像素子1とが透明接着材6によって接着されているため、光は透明接着材6を通過するとき減衰することなく撮像素子1に入射される。

【 0 0 3 3 】

また、光は、接着部7にも入射される。接着部7に入射した光は、ここで吸収又は反射等されて光の透過率が小さくなる。この光が撮像素子1の画素上に入射されるとライン欠陥になるが、上述したように、ファイバプレート2の大きさと撮像素子1との大きさを同じにして、これらを位置合わせすると接着材7からの光が撮像素子1の画素に影響を与えにくい構成となっている。

【 0 0 3 4 】

撮像素子1では、入射された光を、光の強度に応じた電気信号に変換する。この電気信号は、図示しない読み出し回路の指示に応じて、バンプ5を介してフレキシブル基板4に読み出される。フレキシブル基板4に読み出された電気信号は、図示しない外部回路基板に送られ、A/D変換された後に画像処理がされる。

【 0 0 3 5 】

図8は、ファイバプレート基体の製造工程を示す模式図である。図8を用いてファイバプレート基体の製造工程について説明する。なお、図8(a)～図8(c)は平面図であり、図8(d)、図8(e)は断面図である。

【 0 0 3 6 】

まず、図8(a)に示すように、ファイバプレート2を相互に、接着部7により貼り合わせる。このとき、図8(a)に示すように、ファイバプレート2は、注意して貼っても厳密にはどうしても相互に位置がずれて貼り合わされるのでファイバプレート間に隙間が発生する。この隙間を解消するため、図8(a)

) の点線部分まで研磨して、図 8 (b) に示すように、片側を平坦化してそろえる。

【 0 0 3 7 】

つづいて、図 8 (a) , 図 8 (b) で説明したのと同様の手順によって、片側がそろえられた 2 枚のファイバースプレートを、相互にそれぞれの平坦面を合わせるように貼り合わせる (図 8 (c)) 。そして、図 8 (c) の点線部分まで研磨して、図 8 (a) , 図 8 (b) で説明したのと同様の手順によって、片側がそろえられた 2 枚のファイバースプレートを、さらに、4 枚のファイバースプレート 2 に貼り合わせる。

【 0 0 3 8 】

こうして貼り合わせたファイバースプレート 2 の断面は、図 8 (d) に示すように、各貼り合わせ部分には、側面を研磨した際や工程中の取り扱いにより、チッピングが生じる。そのため、貼り合わせを終えたファイバースプレート 2 は、表面及び裏面を、それぞれチッピングがなくなるまで両面を研磨して、図 8 (e) に示すような貼り合わせ部に隙間やチッピングのないファイバースプレート基体を作成する。なお、図 8 (e) に示すファイバースプレート基体は、図 7 (c) を用いて説明したように、スペーサ 1 3 を介して、ベース基板 1 0 側と貼り合わせされる。

【 0 0 3 9 】

なお、ここでは、6 枚のファイバースプレート 2 を貼り合わせてファイバースプレート基体を製造する場合を例に説明したが、実際には、ファイバースプレート基体が所要の大きさになるように、所定の枚数のファイバースプレート 2 を貼り合わせる。

【 0 0 4 0 】

(実施形態 2)

図 9 (a) は、本発明の実施形態 2 に係るファイバースプレート基体の断面図である。図 9 (b) は、図 9 (a) の破線部分の拡大図である。図 9 には、鉛等の X 線遮蔽部材を含有したエポキシ樹脂等を接着材によって、ファイバースプレート 2 を相互に接続して、ファイバースプレート基体を作成している様子を示している

【 0 0 4 1 】

本実施形態のX線撮像装置は、蛍光体3に入射したX線のうち、光に変換されないものが撮像素子1に入射するのを防止するものである。すなわち、蛍光体3に入射したX線のうち、光に変換されないものは、鉛等を含ませたファイバークラウドプレート2及び遮蔽性部材を含ませた接着材によって遮蔽する。こうして、本実施形態では、撮像素子1にX線が入射されることを防止して、ノイズ等の発生を抑制している。

【 0 0 4 2 】

なお、接着材には、エチレン・酢酸ビニル共重合体、カルボキシル変性エチレン・酢酸ビニル共重合体、エチレン・イソブチルアクリレート共重合体、ポリアミド、ポリエステル、ポリメチルメタクリレート、ポリビニルエーテル、ポリビニルブチラール、ポリウレタン、スチレン・ブチレン・スチレン(SBS)共重合体、カルボキシル変性SBS共重合体、スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)共重合体、スチレン・エチレン・ブチレン・スチレン(SEBS)共重合体、マレイン酸変性SEBS共重合体、ポリブタジエンゴム、クロロプレンゴム(CR)、カルボキシル変性CR、スチレン・ブタジエンゴム、イソブチレン・イソプレン共重合体、アクリロニトリル・ブタジエンゴム(NBR)、カルボキシル変性NBR、エポキシ樹脂、シリコーンゴム(SR)などが挙げられ、これらは1種単独または2種以上を組合せて使用される。

【 0 0 4 3 】

さらに、必要に応じて、反応性助剤、架橋剤としてのフェノール樹脂、ポリオール類、イソシアネート類、メラミン樹脂、尿素樹脂、ウロトロピン樹脂、アミン類、酸無水物、過酸化物、金属酸化物、トリフルオロ酢酸クロム塩などの有機金属塩、チタン、ジルコニア、アルミニウムなどのアルコキシド、ジブチル錫ジオキサイドなどの有機金属化合物、2,2-ジエトシキアセトフェノン、ベンジルなどの光開始剤、アミン類、リン化合物、塩素化合物などの増感剤、さらには硬化剤、加硫剤、制御剤、劣化防止剤、耐熱添加剤、熱伝導向上剤、軟化剤、着色剤、各種カップリング剤、金属不活性剤などを適宜添加してもよい。

【 0 0 4 4 】

また、遮蔽性部材には、鉄、コバルト、ニッケル、銅、亜鉛、銀、スズ、ガドリニウム、タングステン、白金、金、鉛、ビスマスなどの重金属及びその化合物もしくは合金や、半田 (P b - S n) ペースト、銀ペーストで用いる合金、金属粒子や、無機もしくは有機材からなる粒 (カーボン粒子、プラスチックボール) にメッキ、スパッタ等で重金属を皮膜した粒子などを用いることができる。

【 0 0 4 5 】

図 1 0 は、図 9 に示すファイバプレート基体の製造工程の説明図である。まず、図 1 0 (a) に示すように、接着材と X 線遮蔽部材とを攪拌棒などを用いて攪拌する。それから、攪拌によって生じた泡がなくなった後に、ディスペンサーもしくはスクリーン印刷でファイバプレート間に X 線遮蔽部材を含有する接着材を充填する (図 1 0 (b))。充填は、隙間の空気が抜けやすいように真空雰囲気内で行うとよい。

【 0 0 4 6 】

そして、ファイバプレート 2 を相互に加圧しながら接着材を硬化させる。硬化には、UV 照射や、常温 ~ 2 0 0 ° C の範囲で加熱するとよい。その後、ファイバプレート 2 の上面よりはみ出した接着材を削り取る (図 1 0 (c))。こうして、ファイバプレート基体を形成する。

【 0 0 4 7 】

(実施形態 3)

図 1 1 は、本発明の実施形態 3 に係るファイバプレート基体の断面図である。本実施形態では、低融点金属 (融点が 3 3 0 ° C 以下の金属) 及び液状フラックスを用いてファイバプレート基体を作成する。

【 0 0 4 8 】

低融点金属には、P b、S n、B i、S b、I n、A g、C d などの金属を 2 種以上含む合金、例えば S n - P b (6 3 : 3 7 w t %) の共晶半田や S n - P b (1 0 : 9 0 w t %) の高融点半田を用いることができる。また、低融点金属は、液状フラックスに混ざりやすいように、粒形状であることが望ましい。

【 0 0 4 9 】

また、液状フラックスには、ロジン系液状フラックスでは、精製ロジン、水添ロジン、重合ロジン等の樹脂成分及びアルコール類、例えばテルピネオール、1,4-ブタンジオール、メチルセロソルブ等、又はケトン類、例えばメチルエチルケトン、メチルイソプロピルケトン、メチルイソブチルケトン等の溶剤成分を必須成分とし、これに更にポリエチレングリコール、ポリビニルブチラール、石油樹脂等の粘度調整剤、マロン酸、コハク酸、トリエタノールアミン等の活性剤などの添加剤成分を適宜配合したものが用いられる。

【 0 0 5 0 】

また、水溶性の液状フラックスとしては、ポリエチレングリコール、グリセリン、ポリビニルアルコール等の多価アルコール成分、溶剤成分としての水を必須成分とし、これに更にポリアクリル酸アミド等の粘度調整剤、有機酸、有機若しくは無機ハロゲン化塩、塩酸ジエチルアミン等の活性剤などの添加剤成分を適宜配合したものが用いられる。中でも、水溶性の液状フラックスが好ましく使用される。

【 0 0 5 1 】

図 1 2 は、図 1 1 に示すファイバークラウド基体の製造工程の説明図である。まず、図 1 2 (a) に示すように、粉末状の低融点金属と液状フラックスとを混合する。それから、攪拌によって生じた泡がなくなった後に、ディスペンサーもしくはスクリーン印刷でファイバークラウド間に X 線遮蔽部材を含有する液状フラックスを充填する (図 1 2 (b))。充填は、隙間の空気が抜けやすいように真空雰囲気内で行うとよい。

【 0 0 5 2 】

そして、ファイバークラウド 2 を相互に加圧し、同時に融点以上の温度で加熱して低融点金属を融着させる。その後、ファイバークラウド 2 の上面よりはみ出した低融点金属を削り取る。こうして、図 1 0 (c) に示すようなファイバークラウド基体を形成する。

【 0 0 5 3 】

(実施形態 4)

図 1 3 は、本発明の実施形態 4 に係るファイバークラウド基体の断面図である

。本実施形態では、第1、第2の金属層によってファイバプレート貼り合わせしてファイバプレート基体を作成する。

【0054】

図14は、図13に示すファイバプレート基体の製造工程の説明図である。まず、たとえばファイバプレート2の両面に、感光性フィルムなどの耐酸性用エッチングレジストをコーティングする(図14(a))。そして、このレジストを加熱によってファイバプレート2に密着させる。それから、後述する第1の金属層とガラスとの密着性を上げるため、フッ酸、フッ化カリウム、酸性フッ化アンモニウムなどを用いて、ファイバプレート2の端面をエッチングして表面を粗す(図14(b))。

【0055】

つづいて、エッチングした端面にニッケルや銅などの第1の金属層を無電解メッキによって形成する(図14(c))。そして、第1の金属層に、合金である第2の金属層を電気メッキする(図14(d))。第2の金属層はガラスのような不導体に直接メッキすることが難しい。そこで上述した第1の金属層を先に設けて導体処理を行い、その後に第2の金属層を電気メッキ処理によって形成する。

【0056】

それから、レジストを剥離して、ファイバプレート2を相互に加圧しながら、第2の金属層を融点以上330℃以下の温度で加熱する(図14(e))。その後、ファイバプレート2の上面よりはみ出した第1、第2の金属層を削り取る。こうして、ファイバプレート基体を形成する。

【0057】

以上説明したように、実施形態2~4では、X線を遮蔽する遮蔽性を有する接着部によってファイバプレート2を相互に接続するようにしているため、蛍光体3で光に変換されないでファイバプレート基体側へ出射したX線がファイバプレート基体で遮蔽されるため、撮像素子1を入射されず、ノイズ等の発生を抑制することができる。

【0058】

(実施形態5)

図15は、実施形態1で説明したX線撮像装置を備えた非破壊検査システムの構成を示す概念図である。図15には、実施形態1で説明したX線撮像装置1000と、たとえば電気機器に組み込まれる非破壊検査対象物である被写体2000と、被写体2000にX線を照射するマイクロフォーカスX線発生器3000と、X線撮像装置1000から出力される信号を処理する画像処理装置6000と、画像処理装置6000によって処理された画像を表示するモニタ4000と、画像処理装置6000及びモニタ4000を操作するコントローラ5000とを示している。

【0059】

図15に示す非破壊検査システムは、マイクロフォーカスX線発生器3000によって発生されたX線を、非破壊検査を行いたい被写体2000に照射すると、被写体2000の内部における破壊の有無の情報が、X線撮像装置1000を通じて画像処理装置6000に出力される。画像処理装置6000では、出力された信号を、前述している各撮像素子1の周辺画素間の画像信号を処理したり、ダーク補正などを施して、モニタ4000に画像として表示する。

【0060】

モニタ4000に表示されている画像は、コントローラ5000によって指示を入力することで、たとえば拡大又は縮小したり、濃淡の制御等を行うことができる。こうして、モニタ4000に表示された画像を通じて、被写体2000の内部における破壊の有無を検査する。そして、被写体2000に破壊が発見されなければ、それを良品とみなして電気機器に組み込む。一方、被写体2000に破壊が発見されれば、それを不良品とみなして製造工程から除外する。

【0061】

(実施形態6)

図16は、実施形態1で説明したX線撮像装置を備えたX線診断システムの構成を示す概念図である。図16には、X線撮像装置1000を備えたベッドと、被写体2000にX線を照射するためのX線発生装置7000と、X線撮像装置1000から出力される画像信号の処理及びX線発生装置7000からのX線の

照射時期等を制御するイメージプロセッサ-8000と、イメージプロセッサ-8000によって処理された画像信号を表示するモニタ4000とを示している。なお、図16において、図9で示した部分と同様の部分には、同一の符号を付している。

【0062】

図16に示すX線診断システムは、X線発生装置7000は、イメージプロセッサ-8000からの指示に基づいてX線を発生させ、このX線をベッド上の被写体2000に照射すると、被写体2000のレントゲン情報がX線撮像装置1000を通じてイメージプロセッサ-8000に出力される。イメージプロセッサ-8000では、出力された信号を、前述している各撮像素子1の周辺画素間の画像信号を処理したり、ダーク補正などを施して、図示しないメモリに格納したり、モニタ4000に画像として表示する。

【0063】

モニタ4000に表示されている画像は、イメージプロセッサ-8000によって指示を入力することで、たとえば拡大又は縮小したり、濃淡の制御等を行うことができる。こうして、モニタ4000に表示された画像を通じて、医師が被写体2000を診察する。

【0064】

また、医師が診察した後の被写体2000のレントゲン情報は、本システムの記録手段を設けて、フロッピーディスクなどの記録媒体に記録するようにしてもよい。

【0065】

なお、以上説明した本発明の各実施形態では、X線を用いた場合を例に説明したが、 α 、 β 、 γ 線等の放射線を用いることができる。また、光は画素により検出可能な波長領域の電磁波であり、可視光を含む。さらに、たとえば放射線を含む電磁波を電気信号に変換する電磁波電気信号変換装置にも適用することができる。

【0066】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によると、ファイバースプレートの基体を、複数のファイバースプレートを相互に遮蔽性物質を含む接着材を用いて貼り合わせることに
よって作成するため、撮像素子にX線が入射しないようなX線撮像装置を製造
することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の実施形態 1 の X 線撮像装置の断面図である。

【図 2】

図 1 の撮像素子の概略的な構成を示す平面図である。

【図 3】

図 1 のバンプ及びフレキシブル配線基板付近の概略図である。

【図 4】

図 3 に示したバンプとフレキシブル基板との電氣的接続の様子を示す図である。

【図 5】

図 1 の撮像素子のフレキシブル配線基板付近の拡大図である。

【図 6】

図 1 の撮像素子とベース基板との接着工程を示す図である。

【図 7】

図 1 の撮像素子及びベース基板とファイバースプレート基体とを貼り合わせる工
程の説明図である。

【図 8】

図 1 のファイバースプレート基体の製造工程を示す模式図である。

【図 9】

本発明の実施形態 2 に係るファイバースプレート基体の断面図である。

【図 1 0】

図 9 に示すファイバースプレート基体の製造工程の説明図である。

【図 1 1】

本発明の実施形態 3 に係るファイバースプレート基体の断面図である。

【図 1 2】

図 1 1 に示すファイバプレート基体の製造工程の説明図である。

【図 1 3】

本発明の実施形態 4 に係るファイバプレート基体の断面図である。

【図 1 4】

図 1 3 に示すファイバプレート基体の製造工程の説明図である。

【図 1 5】

実施形態 1 で説明した X 線撮像装置を備えた非破壊検査システムの構成を示す概念図である。

【図 1 6】

実施形態 1 で説明した X 線撮像装置を備えた X 線診断システムの構成を示す概念図である。

【図 1 7】

従来技術 1 の X 線撮像装置の斜視図である。

【図 1 8】

従来技術 2 の X 線撮像装置の斜視図である。

【符号の説明】

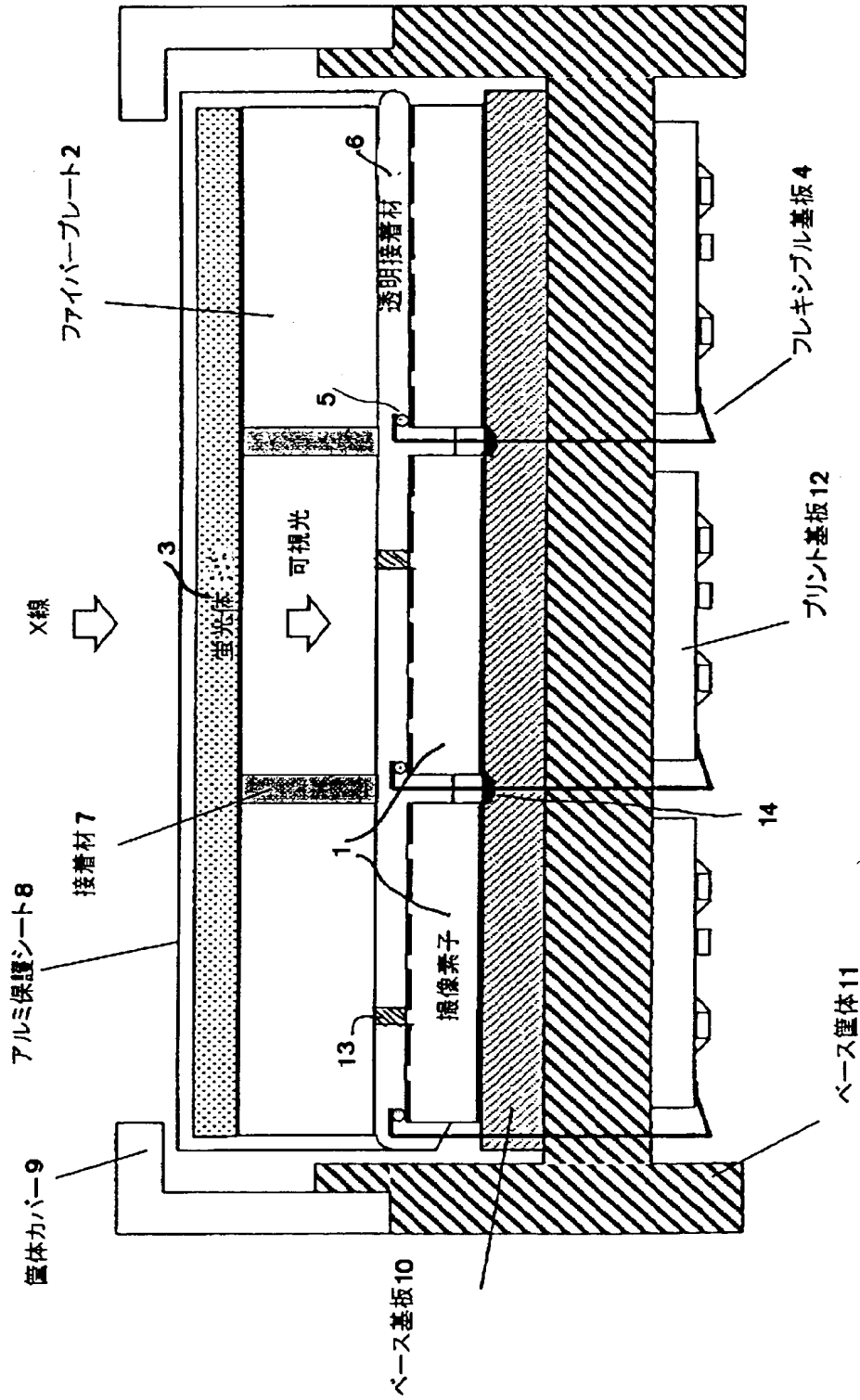
- 1 撮像素子
- 2 ファイバプレート
- 3 蛍光体（波長変換手段）
- 4 フレキシブル基板
- 5 バンプ
- 6 透明接着材
- 7 接着材
- 8 アルミ保護シート
- 9 筐体カバー
- 10 ベース基板
- 11 ベース筐体
- 12 プリント基板

1 3 スペーサ

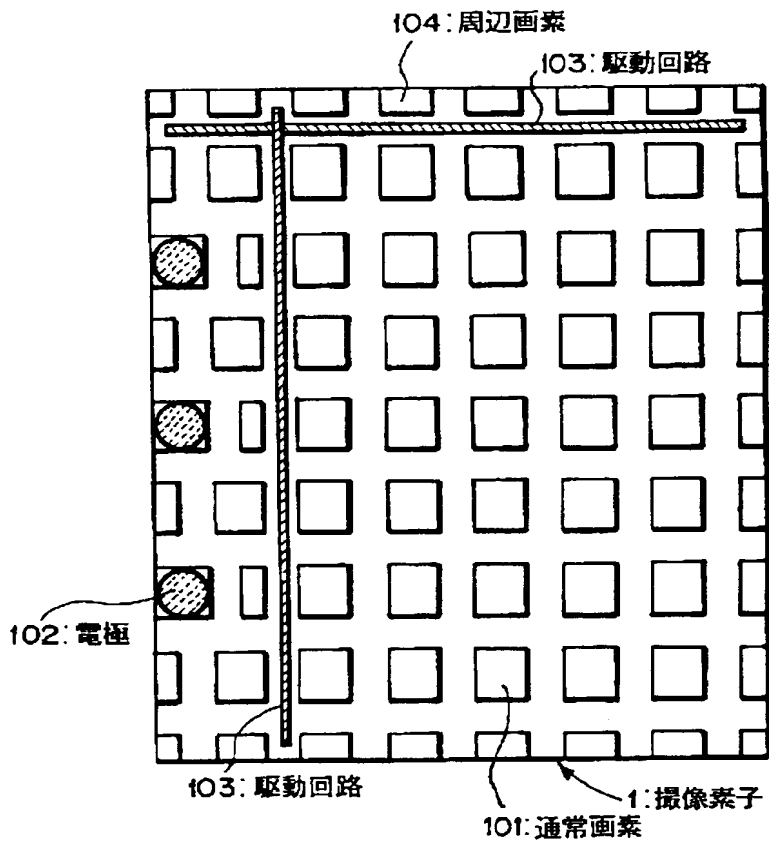
1 4 目地うめ接着材

【書類名】 図面

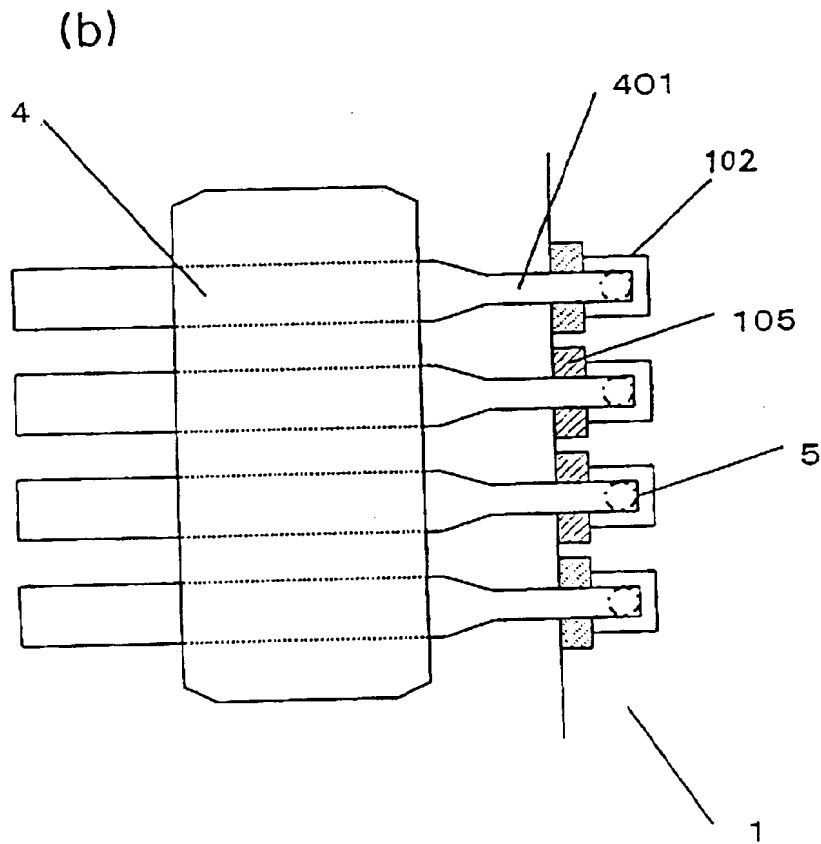
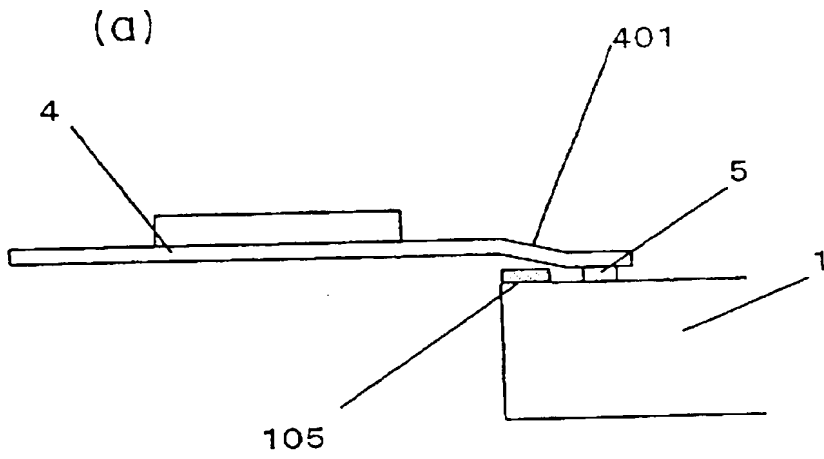
【図1】



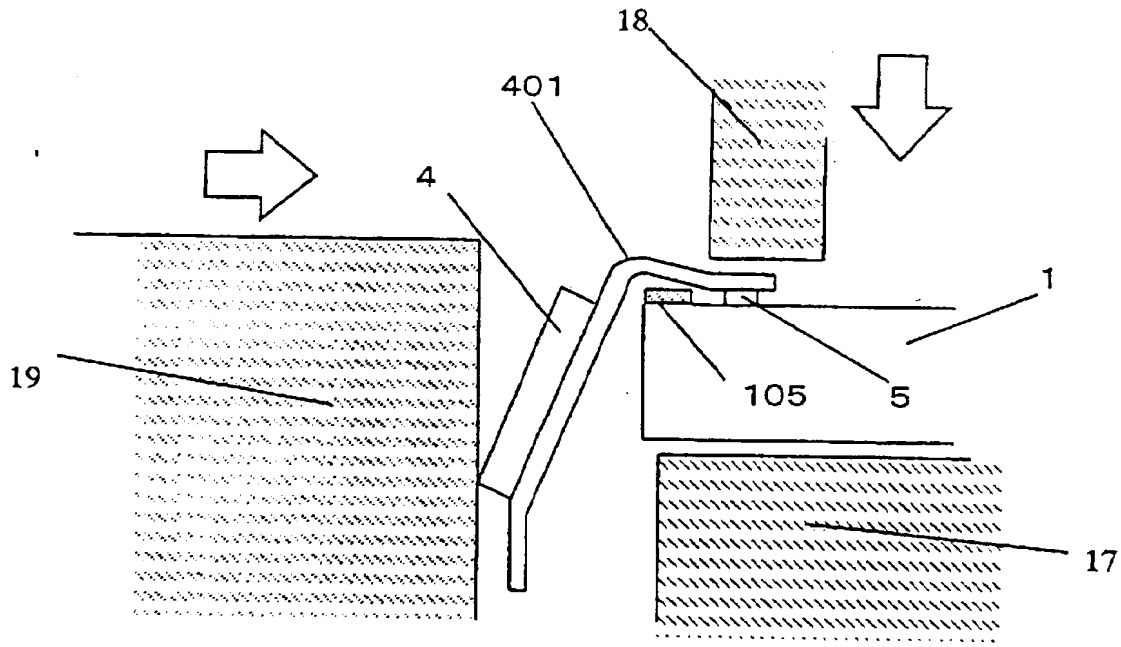
【 図 2 】



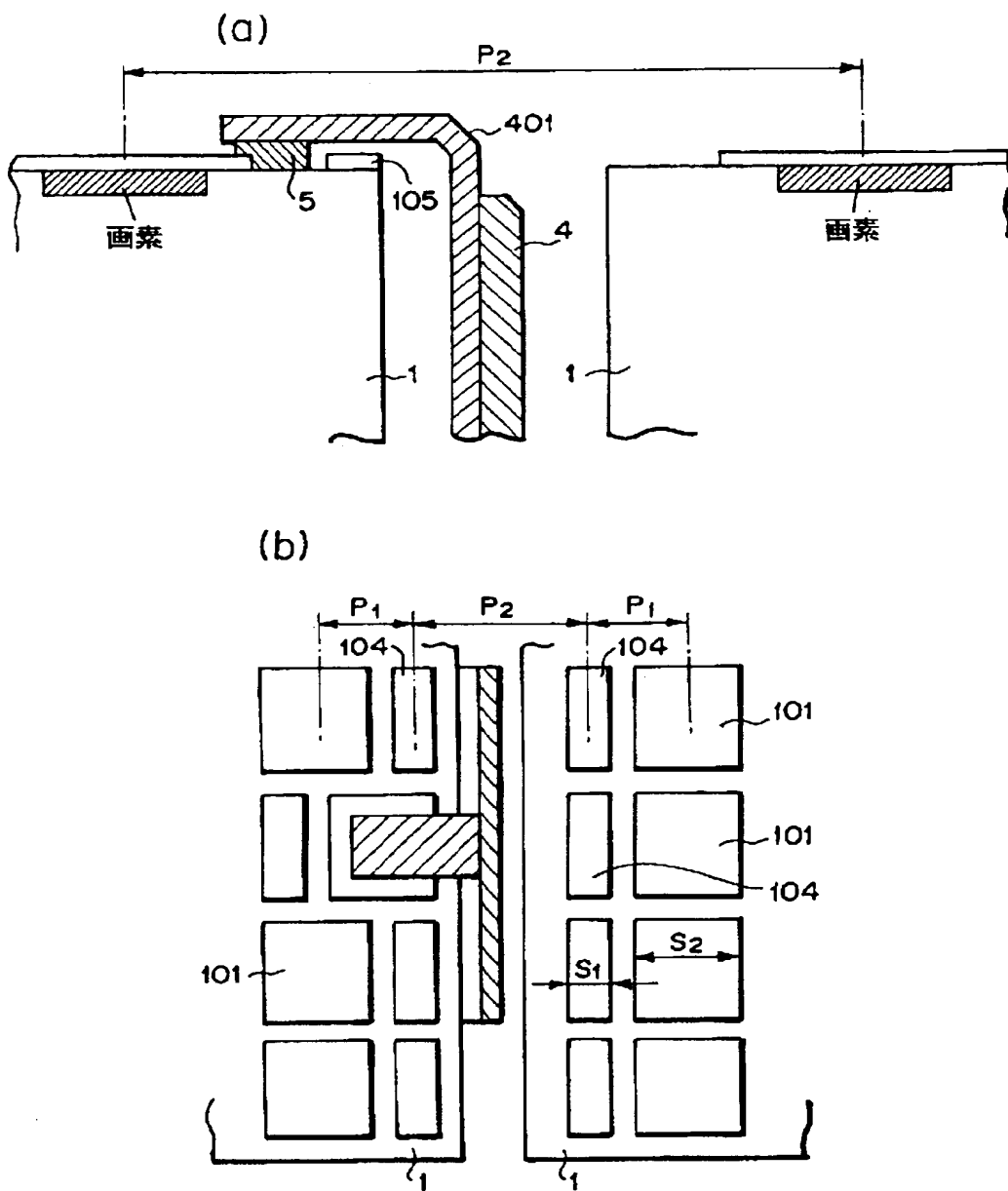
【図3】



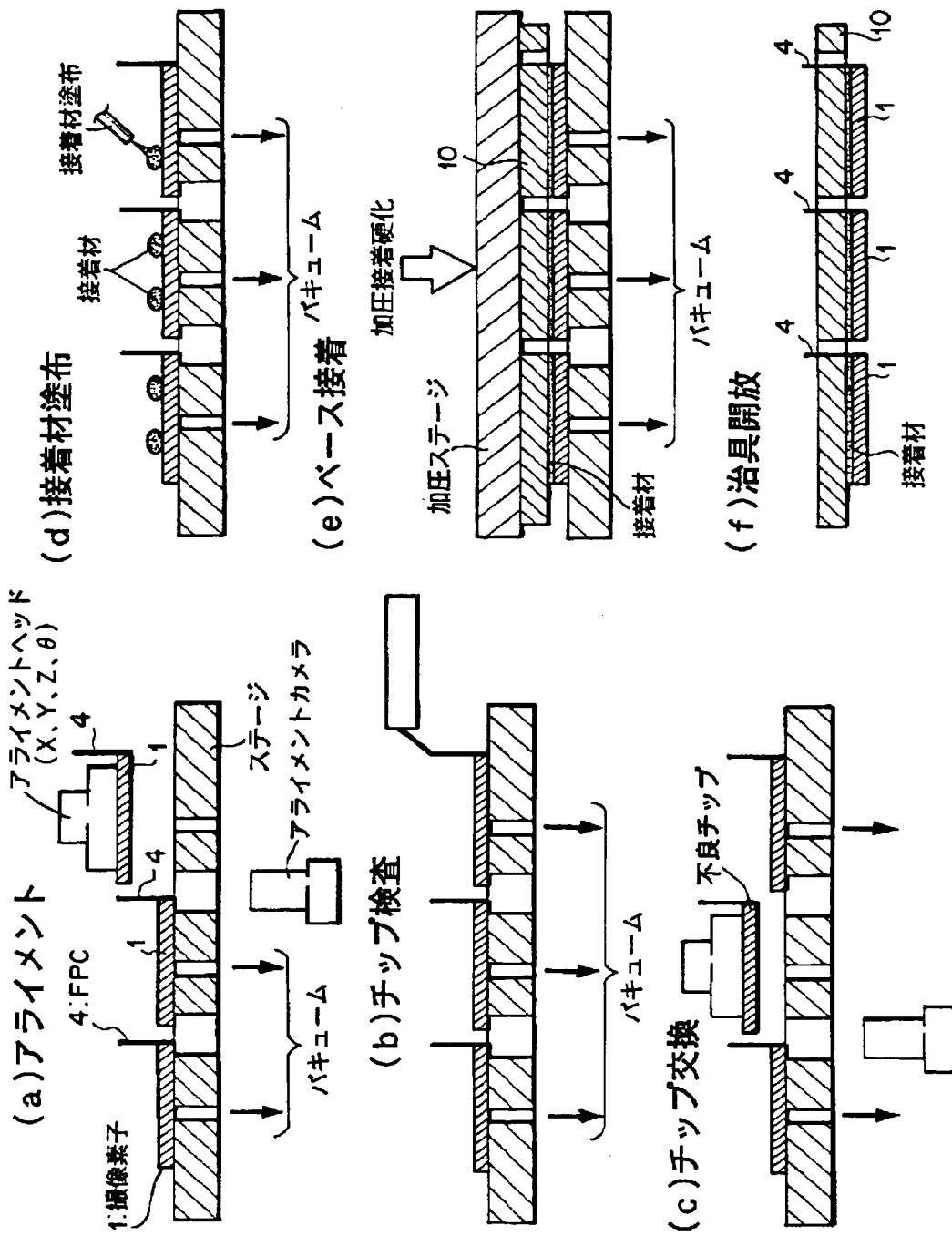
【図4】



【図 5】

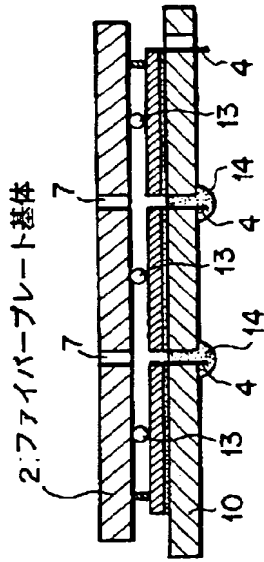


【図6】

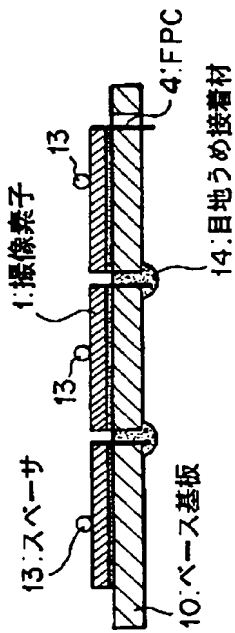


【図7】

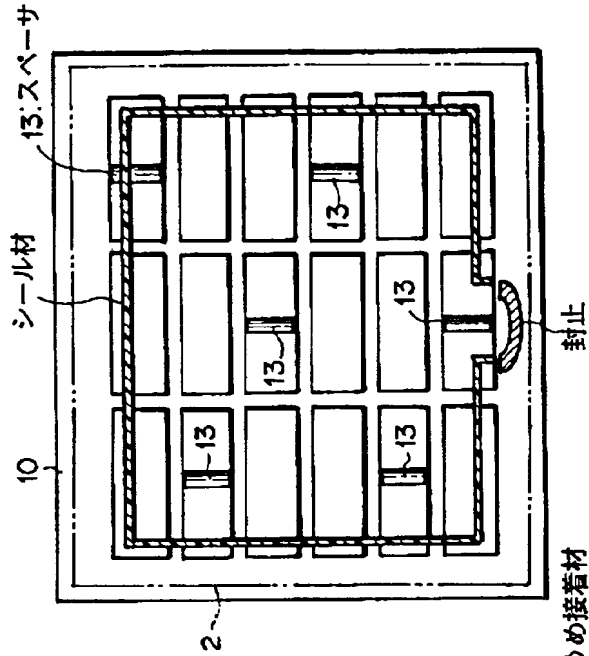
(c) 貼り合わせ



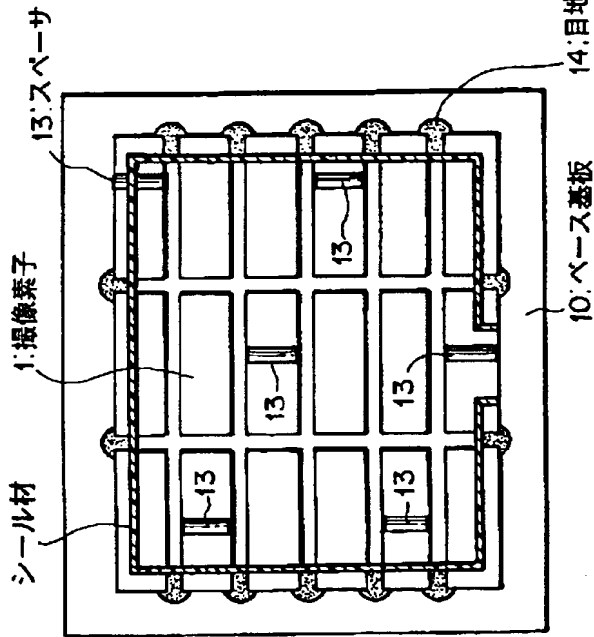
(a) 樹脂スペーサー散布



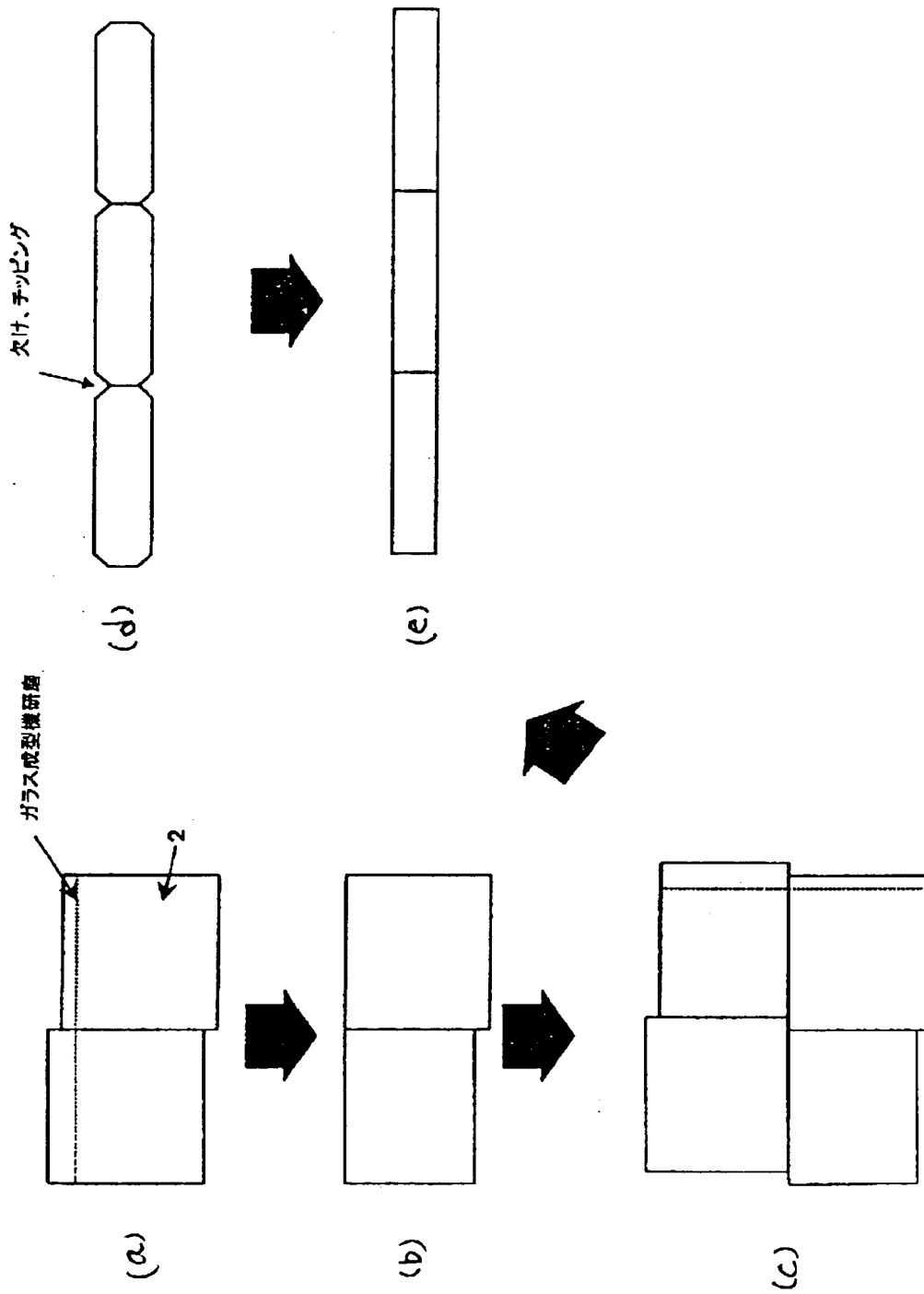
(d) 真空注入と封止



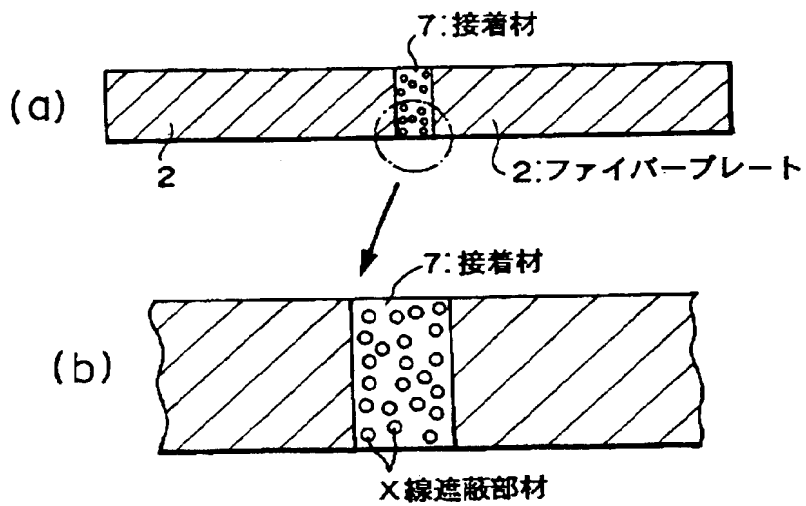
(b) シール材塗布



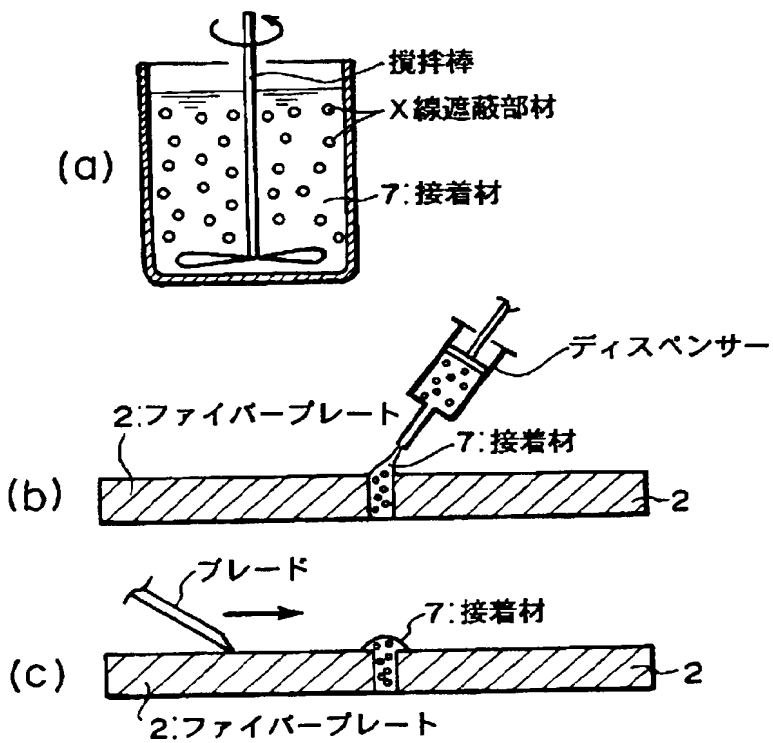
【図 8】



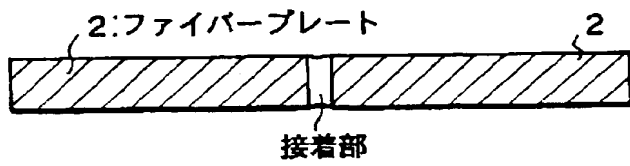
【図9】



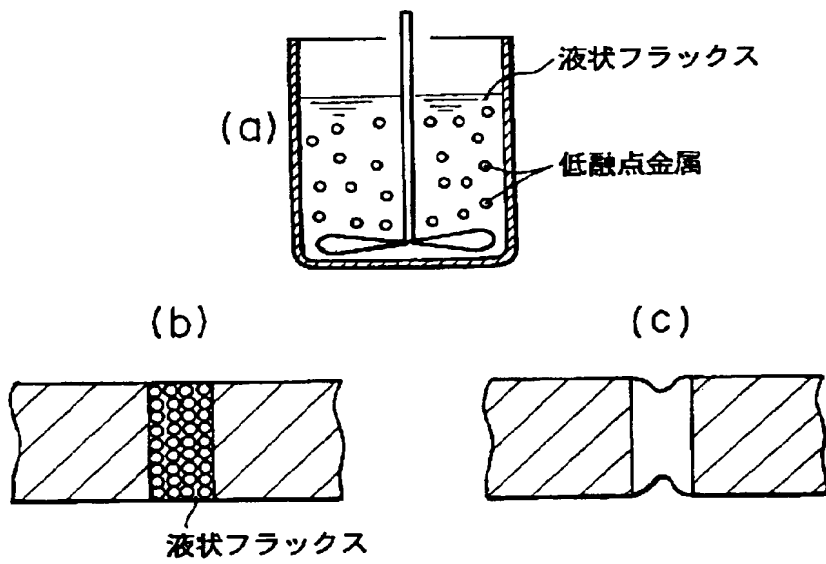
【図10】



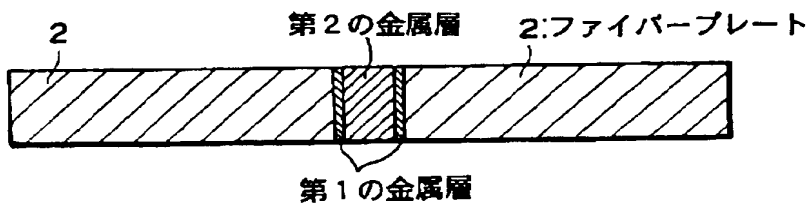
【図11】



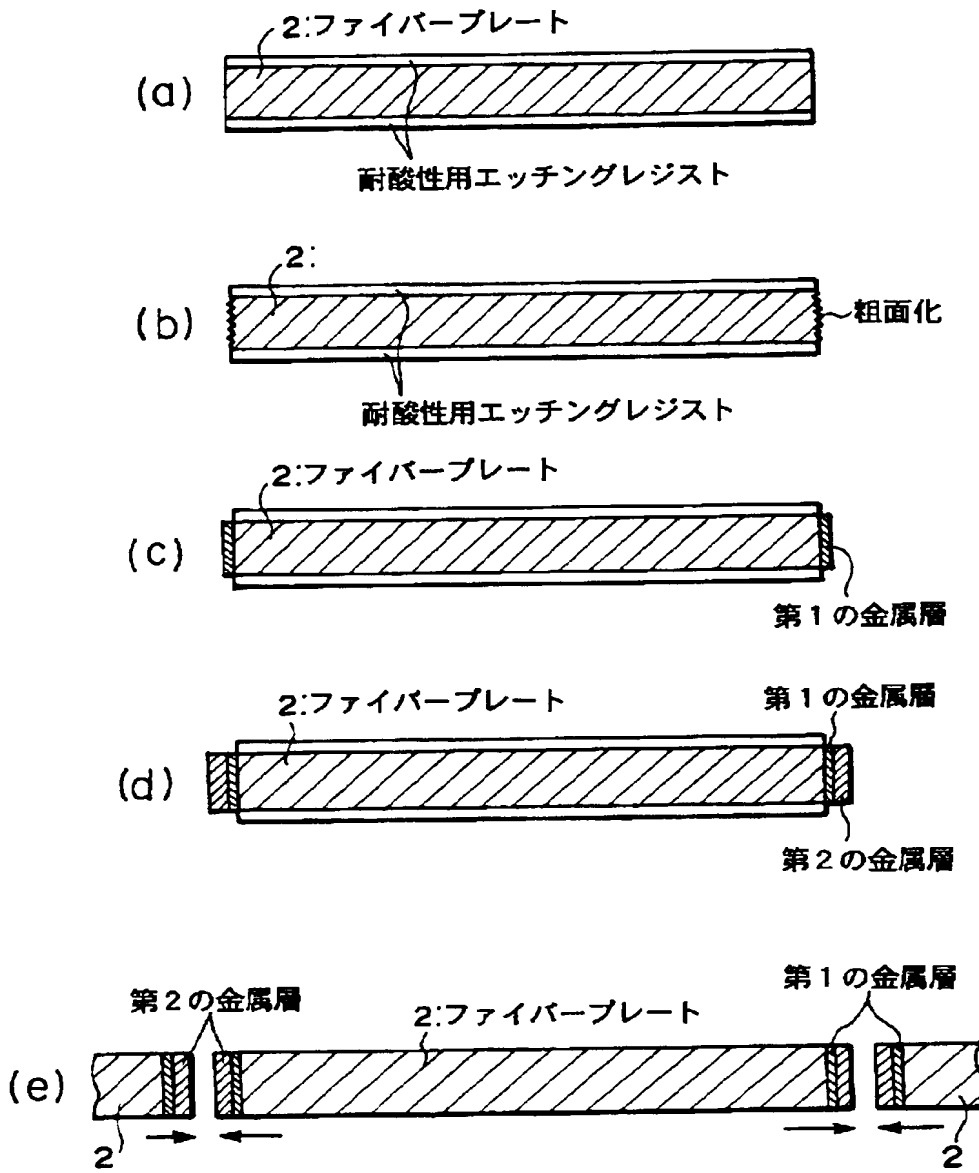
【図12】



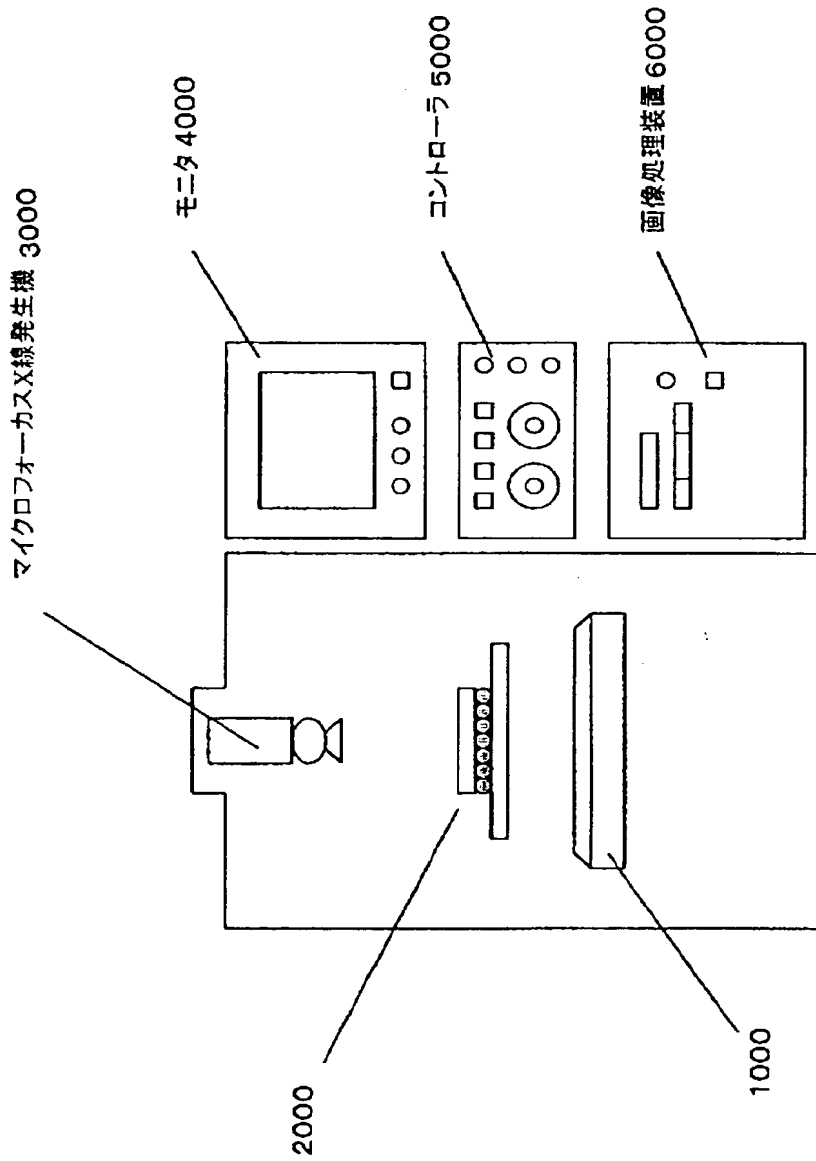
【図13】



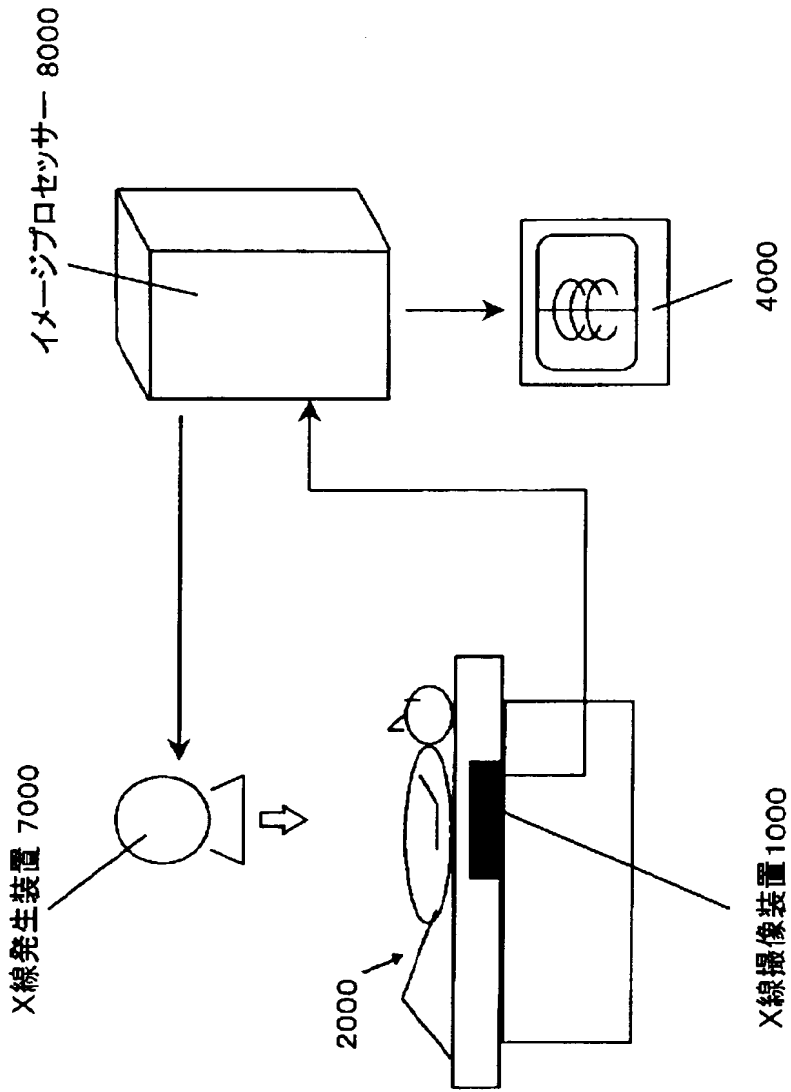
【図 1 4】



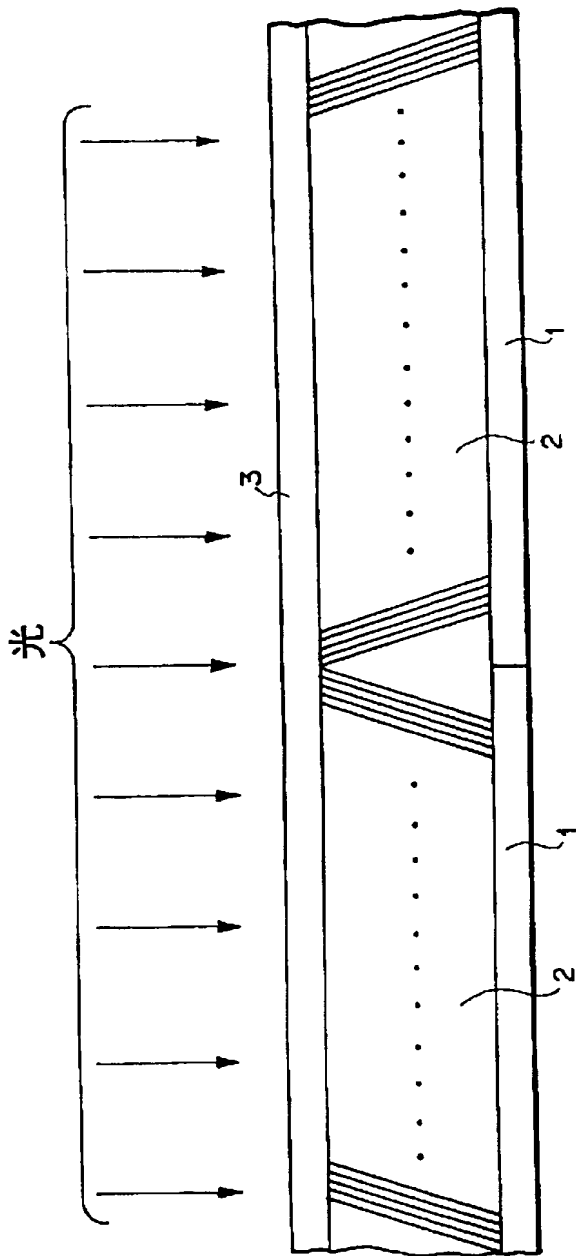
【図15】



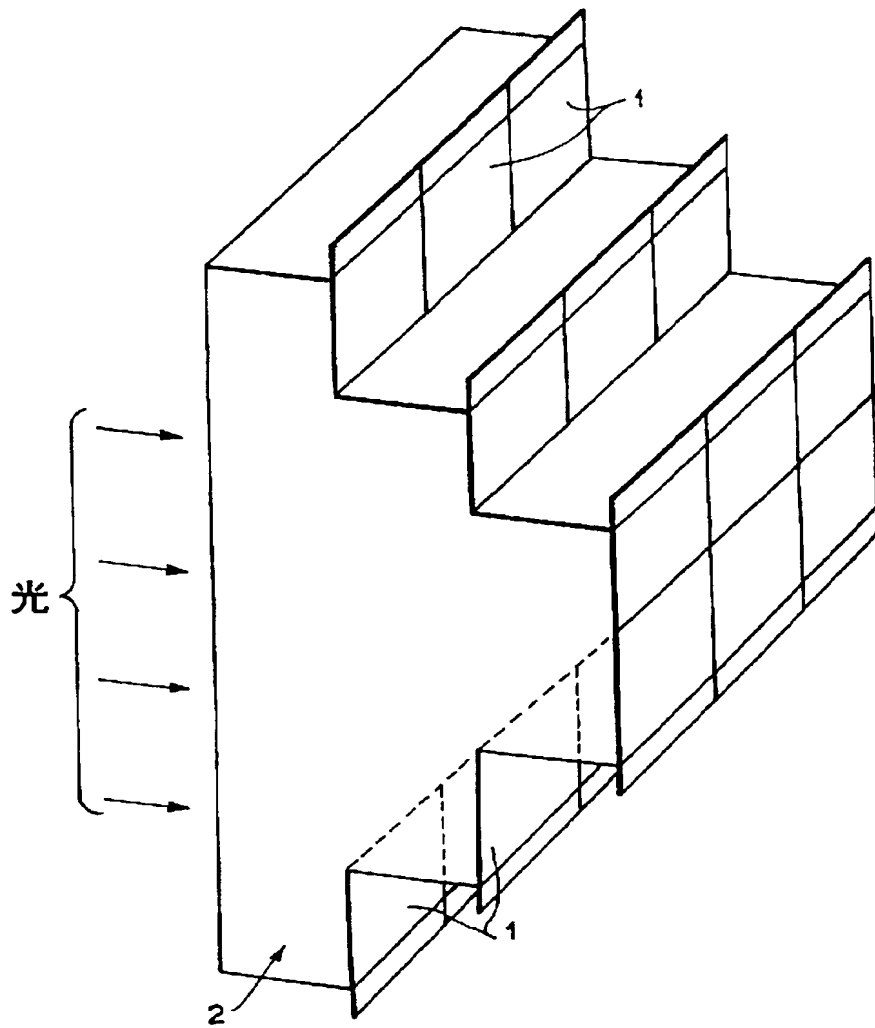
【図16】



【图17】



【图 1 8】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 撮像素子にX線が入射しないようなX線撮像装置を製造する。

【解決手段】 放射線を光に変換する波長変換手段と、変換されることによって得られた前記光を電気信号に変換する光電変換手段と、前記波長変換手段と前記光電変換手段との間に設けられ前記波長変換手段からの光を前記光電変換手段へ導く複数のファイバプレートとを有するファイバプレート基体とを備えた放射線撮像装置であって、前記ファイバプレート基体は、複数の前記ファイバプレートを相互に遮蔽性物質を含む接着材を用いて貼り合わせることで作成されている。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号 [000001007]

1. 変更年月日 1990年 8月30日
[変更理由] 新規登録
住所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号
氏名 キヤノン株式会社